

凝聚态物理-北京大学论坛

2012年第17期

半导体的巨磁电阻

章晓中 教授

时间：9月27日（星期四）15:00—16:40

地点：北京大学物理大楼中212教室

章晓中，牛津大学博士（1989），英国皇家研究院博士后研究员（1989—92），新加坡国立大学物理系讲师、高级讲师（1992—99）。1999年回国任清华大学材料科学与工程系教授（博导），曾任清华大学电子显微镜实验室主任，现任先进材料教育部重点实验室副主任、全国纳米技术标委会副主任委员。目前的研究领域为：自旋电子学材料、多铁性材料、纳米材料与纳米结构、材料的电子显微学及计算材料学。已在Nature等SCI收录杂志上发表论文150多篇，获中国发明专利14项，他的硅基磁电阻工作入选2011年度“中国科学十大进展”和2011年度“中国高等学校十大科技进展”。

报告摘要：本报告介绍我们发明的一种用半导体(Si,GaAs,Ge)制备的巨磁电阻器件。用半导体制备磁电阻器件的优点是：使得磁传感器可以与半导体微电子器件或半导体光电器件兼容，可能导致半导体“磁电”器件或“磁光电”器件的诞生，可能催生半导体工业和磁传感器工业的联姻。该工作发表在《Nature》上，还入选2011年度“中国科学十大进展”和2011年度“中国高等学校十大科技进展”。

联系人:杨金波教授，邮箱: jbyang@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

<http://www.phy.pku.edu.cn/~icmp/forum/njt.xml>

Photoed by Xiaodong Hu